

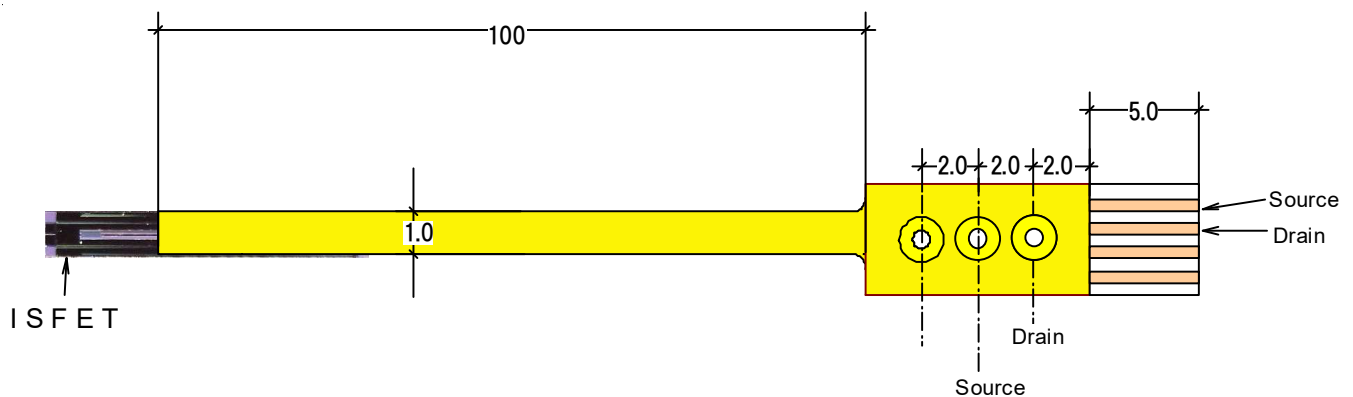
イオン感応型電界効果トランジスタ (Ion-Sensitive Field-Effect Transistor) をFPC (Flexible printed circuits) に実装。

「ISFETの構成」は下記のようになっています。

1. 材料：p型シリコン
2. 構造：シリコン基板上に接合分離した絶縁膜ゲート型電界効果トランジスタ
3. ゲート絶縁膜：Si₃N₄膜 (特注)
- 4.
5. Nチャンネル、デプレッション型 ISFET です。(比較電極で若干異なります)

ドレイン電流 I_d (μA)	ゲート電圧 V_{gs} (mV)
10~200	-0~-1400

6. 形状：1mm幅のチップ内にゲート部と電極パッドを分離して配置。
ドレイン (D) 電極、ソース (S) 電極端子は、下図の配置になっています。



FPC用コネクタ：日本航空電子工業製
1L-402R-4S-S1L または FC1-S-004-H

アイسفエトコム株式会社

〒350-1233 埼玉県日高市下鹿山 319 番 3 号

tel: 042-980-5349

e-mail1: ito@isfet.com

<http://www.isfet.com>